

5584ИР23(А)Т

## Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе

Микросхемы представляют собой быстродействующую логическую схему, изготовленную по КМОП технологии и предназначенную для использования в высокопроизводительных вычислительных системах с широким диапазоном напряжения питания.

Микросхемы допускают возможность работы в режиме превышения напряжения по входу до 7 В без ухудшения характеристик и надежности микросхем. Данная возможность позволяет использовать микросхемы в радиоэлектронных устройствах для сопряжения микросхем с напряжениями питания 5 В и 3 В, исключает выход из строя микросхемы при аварийном отключении источника напряжения питания.

Применение блока формирования выходного фронта в составе микросхемы позволяет уменьшить амплитуду помех при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние.

Входные и выходные уровни микросхем соответствуют уровням КМОП.

### Особенности:

- Диапазон напряжения питания от 2.0 до 5.5 В.
- Выходной ток 12 мА.
- Низкий ток потребления: 0.2 мкА (типичное значение) при  $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$ .
- Допустимое значение статического потенциала не менее 2000 В.
- Диапазон рабочих температур среды от минус 60 до плюс 125  $^\circ\text{C}$ .
- Сбалансированная задержка распространения сигнала.
- Обеспечивает режим превышения напряжения по входу.
- Низкий уровень шума при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние:  
 $V_{OLP} = 0.8\text{ В (max)}$ .

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы не регламентируется.

Наиболее близкими по составу параметров разрабатываемой схемы являются микросхемы серии 74VHCxxx ф. Toshiba, Япония, прямой аналог отсутствует.

Микросхема изготавливается в 20-выводном металлокерамическом корпусе типа 4153.20-6.

Первый вывод расположен в левом нижнем углу при правильно ориентированной для чтения маркировке.

Микросхемы должны быть стойкими к воздействию специальных факторов согласно таблице

Условное обозначение микросхемы	Группа исполнения для специального фактора						
	7И1	7И6	7И7	7С1	7С4	7К1	7К4
5584xxxxТ	3Ус	4Ус	0.2×5Ус	10×1Ус	1Ус	5×1К	0.5×1К
5584xxxxАТ	4Ус	6Ус	0.2×5Ус	10×1Ус	1Ус	5×1К	0.5×1К



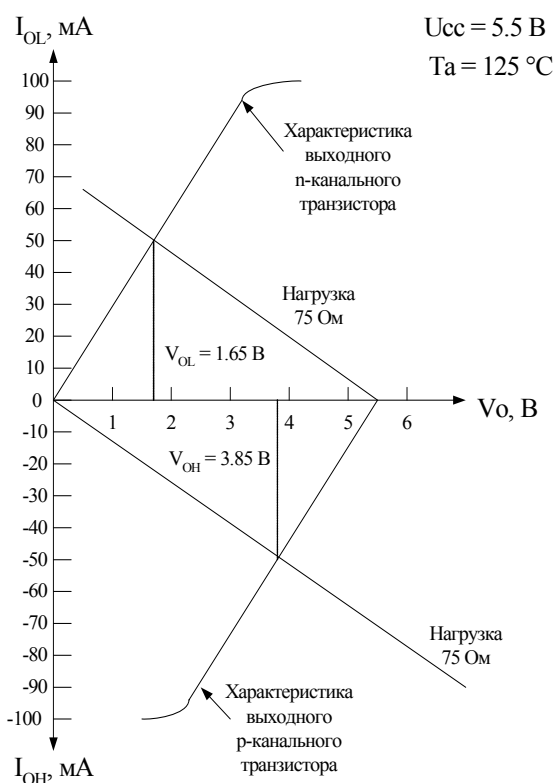
### Предельно допустимые и предельные режимы

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	$U_{CC}$	2.0	5.5	-0.5	7.0
Входное напряжение низкого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	$U_{IL}$	0	0.5	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		0	$0.3U_{CC}$		
Входное напряжение высокого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	$U_{IH}$	1.5	$U_{CC}$	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		$0.7U_{CC}$	$U_{CC}$		
Входное напряжение, В	$U_I$	0	5.5	-0.5	10.0
Напряжение, прикладываемое к выходу, В	$U_O$	0	$U_{CC}$	-0.5	$U_{CC} + 0.5V$ , 10 В <sup>1)</sup>
Напряжение, прикладываемое к выходу в режиме превышения <sup>2)</sup> , В	$U_{OPD}$	0	5.5	0	10.0
Входной ток диода, мА, $U_I \leq -0.5$ В	$I_{IK}$	–	–	–	–25
Выходной ток диода, мА, $U_O < -0.5$ В, $U_O > U_{CC} + 0.5$ В	$I_{OK}$	–	–	–	±25
Выходной ток низкого уровня, мА	$I_{OL}$	–	12	–	–
Выходной ток высокого уровня, мА	$I_{OH}$	–	–12	–	–
Постоянный ток вывода питания или общего вывода, мА	$I_{CC}, I_{GND}$	–	–	–	100
Длительность фронта, спада входного сигнала (за исключением входов триггера Шмитта), нс	$t_{LH}, t_{HL}$	–	3 <sup>3)</sup>	–	–
Емкость нагрузки, пФ	$C_L$	–	50	–	500

<sup>1)</sup> Предельный режим от ( $U_{CC} + 0.5$  В) до 10 В допускается, когда выход микросхемы находится в состоянии "Выключено".

<sup>2)</sup> Режим превышения:  $U_{CC} = 0$  В.

<sup>3)</sup> Длительность фронта, спада входного сигнала (без гарантии динамических параметров) не более 300 нс при  $U_{CC} = (3.3 \pm 0.3)$  В, не более 90 нс при  $U_{CC} = (5.0 \pm 0.5)$  В



Допускается подача входных сигналов на микросхемы и их снятие при выключенном источнике питания.

Рекомендуется вывод "Питание" соединять с выводом "Общий" через конденсатор емкостью  $0.1 \text{ мкФ} \pm 10\%$ .

При эксплуатации незадействованные входы следует подключать к источнику питания или к общему выводу.

Микросхемы по выходу обеспечивают согласование с 75-омной линией. Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением  $75 \text{ Ом}$  приведена на рисунке 1.

Допускается подавать на выход в активном состоянии напряжение от  $(U_{CC} + 0.5 \text{ В})$  до  $10 \text{ В}$  с ограничением по току  $25 \text{ мА}$ .

Сопротивление выходных транзисторов микросхем при условии эксплуатации в соответствии с ТУ соответствует требованию ослабления отраженного сигнала от конечной нагрузки линии с волновым сопротивлением  $75 \text{ Ом}$ . Наличие запасов для наихудших

условий по параметрам  $U_{OL} \leq 1.65 \text{ В}$ ,  $U_{OH} \geq 3.85 \text{ В}$  позволяет обеспечить требуемую помехоустойчивость (на уровне  $30\%$ ) при работе на линию с волновым сопротивлением  $75 \text{ Ом}$ .

**Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов микросхем требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением  $75 \text{ Ом}$  (для наихудшего случая – передачи сигнала на вход микросхемы без подключения согласующего резистора на конце линии)**

**Таблица истинности**

Вход			Выход
$\overline{EZ}$	CL	D	Q
L		H	H
L		L	L
L	L, H,	X	Qo
H	X	X	Z
Примечание – H - высокий уровень напряжения; L - низкий уровень напряжения; X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); Qo - хранение предыдущего состояния; Z - выход в состоянии "Выключено". - переход из низкого уровня в высокий; - переход из высокого уровня в низкий.			

## Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	$\overline{E\bar{Z}}$	Вход разрешения выхода
02	Q0	Выход данных
03	D0	Вход данных
04	D1	Вход данных
05	Q1	Выход данных
06	Q2	Выход данных
07	D2	Вход данных
08	D3	Вход данных
09	Q3	Выход данных
10	GND	Общий вывод
11	CL	Вход тактового сигнала
12	Q4	Выход данных
13	D4	Вход данных
14	D5	Вход данных
15	Q5	Выход данных
16	Q6	Выход данных
17	D6	Вход данных
18	D7	Вход данных
19	Q7	Выход данных
20	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

## Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Напряжение питания, U <sub>CC</sub> , В	Норма параметра		Температура среды, °С
			не менее	не более	
Выходное напряжение высокого уровня, В, при I <sub>OH</sub> = -50 мкА	U <sub>OH</sub>	2.0	1.9	-	25±10, -60, 125
		3.0	2.9		
		4.5	4.4		
при I <sub>OH</sub> = -6 мА		3.0	2.58		25±10
3.0		2.38	-60, 125		
4.5		3.94	25±10		
при I <sub>OH</sub> = -12 мА	4.5	3.70	-60, 125		
Выходное напряжение низкого уровня, В, при I <sub>OL</sub> = 50 мкА	U <sub>OL</sub>	2.0	0.1	-	25±10, -60, 125
		3.0	0.1		
		4.5	0.1		
при I <sub>OL</sub> = 6 мА		3.0	0.36		25±10
3.0		0.50	-60, 125		
4.5		0.36	25±10		
при I <sub>OL</sub> = 12 мА	4.5	0.50	-60, 125		
Входной ток низкого уровня, мкА	I <sub>IL</sub>	5.5	-0.2	-	25±10
		5.5	-2.0		-60, 125
Входной ток высокого уровня, мкА	I <sub>IH</sub>	5.5	0.2	-	25±10
		5.5	2.0		-60, 125
	I <sub>IHI</sub>	0	0.2		25±10
		0	2.0		-60, 125
Ток потребления, мкА	I <sub>CC</sub>	5.5	4.0	-	25±10
		5.5	80.0		-60, 125
Выходной ток утечки в режиме превышения, мкА, при U <sub>O</sub> = 5.5 В	I <sub>OPD</sub>	0	2.0	-	25±10
		0	20.0		-60, 125

## Электрические параметры микросхем при приемке и поставке (продолжение)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Напряжение питания, $U_{CC}$ , В	Норма параметра		Температура среды, °С
			не менее	не более	
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выключено", мкА	$I_{OZL}$	5.5	-	-0.50	25±10
		5.5		-10.0	-60, 125
Выходной ток высокого уровня в состоянии "Выключено", мкА	$I_{OZH}$	5.5		0.50	25±10
		5.5		10.0	-60, 125
Время задержки распространения при включении, выключении, нс, при $C_L = 50$ пФ	$t_{PHL}, t_{PLH}$	3.3±0.3		19.3	25±10
		5.0±0.5		12.4	-60, 125
		3.3±0.3		22.3	
		5.0±0.5		14.4	
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние высокого, низкого уровня, нс, при $C_L = 50$ пФ	$t_{PZH}, t_{PZL}$	3.3±0.3		17.0	25±10
		5.0±0.5		11.9	-60, 125
		3.3±0.3	20.0		
		5.0±0.5	13.9		
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого, низкого уровня в состояние "Выключено", нс, при $C_L = 50$ пФ	$t_{PHZ}, t_{PLZ}$	3.3±0.3	16.5	25±10	
		5.0±0.5	10.7	-60, 125	
		3.3±0.3	19.5		
		5.0±0.5	12.7		
Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц	fc	3.3±0.3	55	25±10	
		5.0±0.5	85	-60, 125	
		3.3±0.3	40		
		5.0±0.5	55		
Примечания Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток). За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока					

## Справочные динамические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Напряжение питания, $U_{CC}$ , В	Норма		Температура, °С	Примечание
			не менее	не более		
Время установления сигнала D относительно сигнала CL, нс	$t_{SU(D-CL)}$	3.3±0.3	6.5	-	25±10	Рисунок 1, 2
		5.0±0.5	6.5			
		3.3±0.3	6.5			
		5.0±0.5	6.5			
Время удержания сигнала D относительно сигнала CL, нс	$t_{H(D-CL)}$	3.3±0.3	2.5		25±10	
		5.0±0.5	2.5		-60, 125	
		3.3±0.3	2.5			
		5.0±0.5	2.5			
Длительность сигнала CL, нс	$t_{W(CL)}$	3.3±0.3	9.0		25±10	Рисунок 1
		5.0±0.5	5.5		-60, 125	
		3.3±0.3	12.0			
		5.0±0.5	9.0			

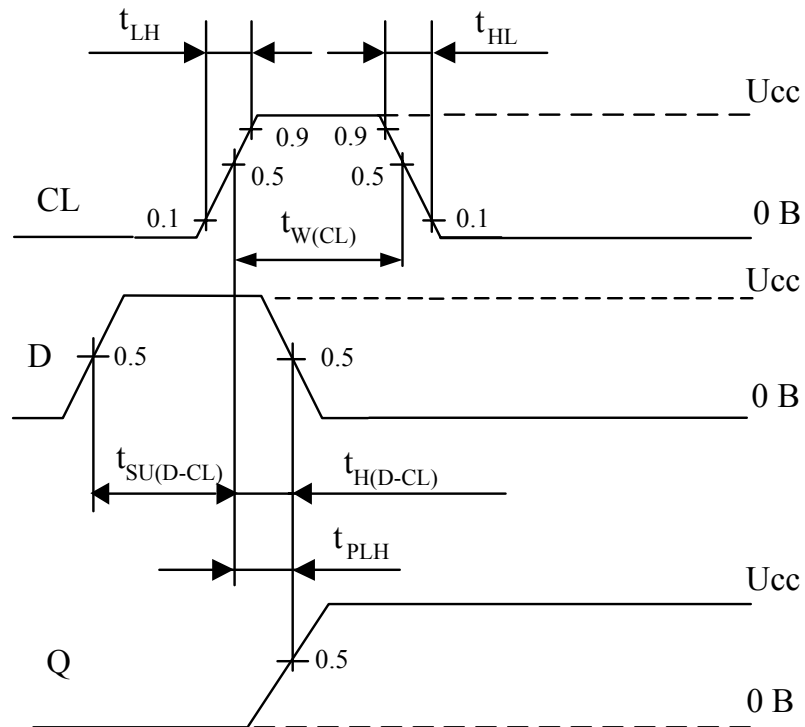


Рисунок 1 – Временная диаграмма входных и выходных импульсов при контроле динамических параметров микросхемы

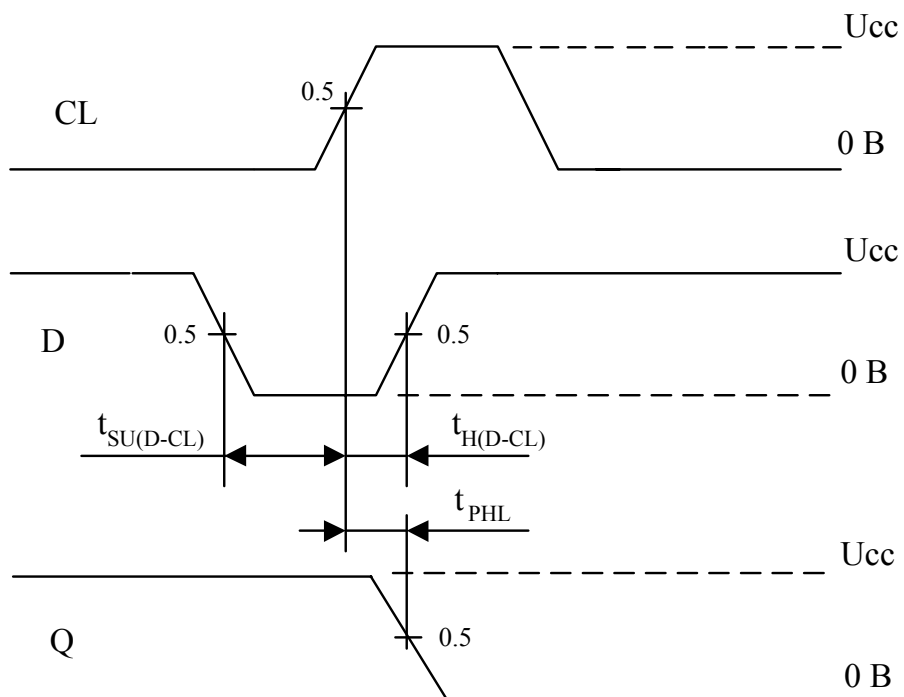


Рисунок 2 – Временная диаграмма входных и выходных импульсов при контроле динамических параметров микросхемы